# DialogClassic Web(tm)

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 THOMSON DERWENT. All rts. reserv.

007717215

WPI Acc No: 1988-351147/198849

XRAM Acc No: C88-155418 XRPX Acc No: N88-266114

Joining nickel-base superalloys - by irradiating with nickel ions, vapour depositing nickel, introducing nickel alloy powder, degassing and hot isostatic pressing

Patent Assignee: KOBE STEEL LTD (KOBM )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 63264283 A 19881101 JP 87100585 A 19870422 198849 B

Priority Applications (No Type Date): JP 87100585 A 19870422 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 63264283 A 5

Abstract (Basic): JP 63264283 A

Heat resisting materials are joined by irradiating high-energy Ni ions on the surface of a Ni-base superalloy being joined in vacuum, to remove oxide film and adsorbed atoms from the surface; then vapour depositing Ni on the surface in vacuum with lowered ion-energy to form 20 microns thick Ni thin film. The treated two surfaces are spaced by a predetermd. interval which is filled with Ni-base alloy powder before degassing and sealing off then hot isostatic pressed for diffusion bonding the two surfaces.

USE/ADVANTAGE - Used for making turbine rotors and rubine blades for gas turbines. Improving bonding strength and reliability of joining. Method is capable of joining curved surfaces. 0/4

Title Terms: JOIN; NICKEL; BASE; SUPERALLOY; IRRADIATE; NICKEL; ION; VAPOUR; DEPOSIT; NICKEL; INTRODUCING; NICKEL; ALLOY; POWDER; DEGAS; HOT;

ISOSTATIC; PRESS

Derwent Class: M13; M23; P55

International Patent Class (Additional): B23K-020/00; C23C-014/02

File Segment: CPI; EngPI

?

# ⑩日本国特許庁(JP)

の告許出頭公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-264283

<pre>⑤Int.Cl.¹</pre>	識別記号	庁内整理番号		49公開	昭和63年(	1988)11月	1日
B 23 K 20/00 C 23 C 14/02 14/16	3 1 0	J -6919-4E 6926-4K 6926-4K	審査請求	未請求	発明の数	1 (全5)	頁)

3発明の名称 耐熱材料の接合方法

②待 頭 昭62-100585

会出 顧 昭62(1987)4月22日

有 世 兵庫県明石市大久保町山手台1-65 母発 明 者 永 田 包発 明 者 明 兵庫県明石市大久保町西島140-3

母発 明 者 山田 保之 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘4丁目8番1号

①出 願 人 株式会社神戸製料所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

3代 理 人 弁理士 宮本 泰一

## 1. 発明の名称

耐熱材料の接合方法

### 2. 特許請求の範囲

1. Ni基因合金の接合すべき面に真空中で高エネ ルギのNiイオンを照射し、表面の酸化被膜。吸着 原子等を除去した後、引続き真空中で前記イオン のエネルギを低下させて上記扱合面にNiを疾者さ せ、膜厚20μ以下の料理膜を形成し、次いで上記 接合面処理を行なった2つの面を所要の隙間を隔 てて対向配置し、その段間にNI基合金粉末を充填 し、その後、該隊間の脱気、密封を行い、しかる 後、然間静水圧加圧処理を施し、Ni基超合金の2 面を拡散接合することを特徴とする耐熱材料の接 合方法。

2. 高エネルギバイオンのイオンエネルギが400 ~5000eVであり、これを20~400eV に低下させる 特許請求の範囲第1項記載の耐熱材料の接合方法。

# 3. 発明の詳細な財明

(産業上の利用分野)

本発明は耐熱材料の接合方法、特にNI基超合金 の拡散接合方法に関するものである。

(従来の技術)

ガスターピン用ターピンロータおよびターピン 異などは超合金からなる素子を所定形状に接合す ることによって製造されており、近時、かかる接 合法として原子の移動を接触低材間に起させる拡 散投合法が信頼の高い方法として適用されている。

しかし、この拡散接合法は接合面の面担さを非 常に細かくすること、接合表面の酸化被膜を除去 し、表面を清浄にすることなど種々の仕上げが要 · 求され、また未接合界面を告無にするためには長 時間、かつ、高圧接触条件下で拡散処理しなけれ ばならないなどの問題を有しており、従って適用 に際し、種々の改良が試みられ、過去、多くの改 良方法が提案されている。例えばそのしつは母材 の被接合変団に予め母材中の主構成元素の拡散込 度よりも大きい拡散速度を有する添加元素を含む 低融点合金層を形成した後、母材の被接合面を接 触加熱して液相拡散接合を行なう方法 (特開昭58 -13487号公報参照)であり、他はインサートノタルとして接合面に厚さ50μm 以下の金箔を使用し、無酸化雰囲気下で1100~1300でに加熱保持しながら加圧、接合する方法(特別昭54-109051 号公報参照)などである。

ところが、このような改良方法も飼者では表面の改化被脱の積極的な除去は行なっておらず、また低融点合金層の成分調整。均一な成分。厚みの層を形成することにかなり困難が予想され、後者では境界面にTiC が折出し強度がでないなどの問題が残り、必らずしも充分な接合を違成するには至らない。

一方、高温高圧ガス雰囲気下で等方的に競処理体に圧縮を加える熱間静水圧加圧(以下、HIPと時記する。)処理を利用し金属材料を拡散接合する方法が提案され注目されている。

このBIP 法による拡散接合はBIP 条件(温度, 圧力,時間) さえ適当に設定すれば同種金属、異 種金属を問わず殆どの金属の拡散接合が可能であ ることからその有用性に関心が高まっている。

即ち、酸化被膜の完全な除去は行なられておらず、 また、強度を低下させるような元素を含んでいる インサートメタルが完全に拡散したかどうかを確 認する方法も示されていない。

本発明は収上の如き実状に対し、更に致化被膜の験去、接合面の清浄化を図る改善された手段を見出することによりNI基超合金のBIP 利用による拡散接合の接合強度をより向上せしめることを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

しかして上記目的を達成する本発明の特徴とするところは、先ずNi茲超合金の複合すべき面に真空中において高エネルギのNiイオンを駆射し、突面の酸化被膜、吸着原子等を除去する。そして引続き真空中で前記イオンのエネルギーを低下させ接合面上にNiを落着させ厚さ20μ以下のNi隔膜を形成する。

次いで上記接合面処理を行なった2つの面を所定の陳間を隔でて対向配置させ、この陳間にNI基 超合金初末を充城する。 しかし、このHIP 法による拡散接合法も前記各 拡散接合法と同様、HIP 処理に先立って接合面の 故化被膜を除去し、接合面を清浄にすることが必 要で、もし接合面に酸化坡膜が存在するままIIP 処理した場合にはその接合力は弱く、場合によっ ては人力によって容易に分離される程度となる。 そこで、本出願人はそれに対処し、さきに被接合 面間に微小間及を設け、該間隙に被接合面表面衍来 などインサート材を充填し密封後、HIP 処理によ り一体化することを提案した。(特開昭56-13109 1 号公報参照)

ところがこの方法も、これをNi基超合金のよう に高硬度の材質のものに適用した場合には、その ままでなお効果が充分とは云えず、接合強度は母 材より弱くなるということが分った。

(発明が解決しようとする問題点)

かように、拡散接合の目標は母材に匹敵する強 度を確実に、かつ経済的に実現することにあるに 均らず、従来の方法は何れも完全とは云い難い。

そして、この隙間の脱気、密封を行ない、のち、 HIP 処理を施し焼結を行なうことによりNI基退合 金の2両を超合金粉末を介して拡散接合するの各 工程からなる。

ここで、上記本発明の真空中における高エネルギNiイオンの照射、接合固上へのNi薄膜の形成には第4回に示す如きイオンプレーティング装置が使用される。

この装置には被処理物にパイアス電源が連なっており、前記N1イオンのエネルギはパイアス電圧によって決まる。例えばパイアス電圧を1000vにすればイオンエネルギも1000ev(エレクトロンボルト)となり、このときのイオン速度は57,000e/aとなる表面の酸化被膜の除去や金属原子、酸化原子のたたき出しには高エネルギが要求され、400~5000evの高エネルギN1イオンが用いられる。

通常、NI基組合金の酸化核酸は10~20人(1~2×10<sup>-1</sup>m)程度であり、これを除去するにはパイプス電圧1000Vのとき最大5min程度で可能である。

一方、イオンのエネルギを低下させるとイオン 自身が彼処理物表面に揃えられ、蒸着することに なる。

従って本発明においてはイオンエネルギ20~40 0 eVに低下させ、これによって20ヵ以下の膜厚を 有するNi 弾膜を接合面に形成する。

この操作はパイアス電圧を20~400Vに下げるだけで容易に行なわれ、例えば100 eVのときのイオン速度は18000m/aである。

従って高エネルギイオンは高速イオンと説み替えることもできる。

なお、Ni 膜厚を20 μ以下としたのは20 μを越え て厚くなると、拡散により合金成分が均一化する のに時間がかかることになり、又、拡散が不充分 では強度が著しく低下するからである。

#### (作用)

上記本発明による拡散接合によれば高エネルギ のイオンを接合面に衝突させることにより従来の 技術では達成し得なかった清冷な表面が得られ、 しかもこれが直ちに別薄膜で覆われるため、その

瀬畑の電圧を変えることによってNiイオンのエネルギが決められ、照射されるが本発明の場合400~5000Vのバイアス電圧、イオンエネルギ400~5000eVの範囲で接合面へのイオン照射が行なわれ、接合面表面の数化玻膜の除去、吸着原子のたたき出しが行われる。

そして、その後、同真空チャンパーの内でパイアス電圧を低下し20~400V、イオンエネルギ20~400eV の範囲に下げ、Niイオンの速度を低くすると今度はNiイオンが被処理接合面に落着を始め、20 μ以下の所要の厚みになるまで落着を行ない、表面にNipp限を形成する。

なお、上記イオン照射、 恋者の間、 真空チャン パーの内は通常、 1×10<sup>-3</sup>torr以下の真空下に保 待する。

このようにしてNi 落ね合金の接合すべき面にNi 薄膜を形成させ、これにもとづいて第1回ないし 第3回に示す接合が行なわれる。

第1図は上述の如くしてNiの薄膜が形成された Ni基盤合金の固体と固体を本発明方法により拡散 後、空気に触れても清浄度に変化を来たさない。

又、上記Nipp設は境界面に金属炭化物が生成するのを防ぎ、前記清浄度の確保と相俟って接合強度を向上し、信頼性を高める。

更に接合面間に介在する粉末は表面にうねり等 があっても空陵が残ることなく、従って曲面の接 合を可能ならしめる。

#### (実施例)

以下、更に本発明の実施例を説明する。

第1図ないし第3図は本発明方法による複合例を示し、第4図は本発明方法におけるNiイオン照射、携着を行なうイオンプレーティング装置の概要を示す。

先ず、後者のイオンプレーティング装置につき 説明すると、同装置は真空チャンパーのを備え、 その内部に被処理物(N) とターゲット金属(T) を 夫々所定の位置に保持する部材の、四及び点火装 置いに連らなるノズルロを有し、被処理物保持部 材のをパイアス電源のに、一方、ターゲット保持 部材のをフーク電源のに大々達箱し、パイアス電

接合する例であり、図において(4)、(8) は上記Ni 課股(3)、(3) をNi 基組合金固体(1)、(1) の各接合 すべき表面に形成したNi 基組合金を示しその接合 面を低かの隙間を隔でてカプセル(4)内にシール溶 接部(5)により溶接固定し、その隙間に超合金粉末 (2)を充壌している。

そして、この状態でその隙間を脱気、密封した 後、BIP 処理し、1180で、1000 kg/dの下に 3 時 間保持すると、被接合面、BI高着層、超合金粉末 層が一体化され強固な接合が達成される。

第2図は上記と同様な方法による拡散接合例で あるが、被処理物の形状が損機な場合を示してい る。

即ち、この場合においてはターピンのロータ及びターピン翼の接合が復復形状のNi基組合金(A)、(B) の接合面にNi薄股(3)、(3) を形成した後、その間に組合金粉末(2)を介在させてこれをシール溶接節(5)により固定してカブセル(4)内に収め、脱気、密封し、HIP 処理により一体化されて行なわれる。

又、第3図はMI基因合金の固体に対し粉末を接

合する場合であり、同じくNipp根はを形成したNi 基因合金の固体(I)をカプセル(4)内に収容し、Ni基 因合金粉末をその上に充塡することによって両者 の投合が行なわれる態機を示している。

以上、本発明の拡散接合において共通することは失ず、接合面に高エネルギバイオンを照射し、表面の放化被膜、吸着原子等を除去した後、引続きイオンエネルギを低下し真空中で町を落着させ接合面上に町の確認を形成させた後に町P処理による焼結、接合を行なうことであり、これによって町基超合金の拡散接合を効果的に達成することが可能となった。

なお、以上の如う複合は同じく耐熱材料である Co基礎合金においても同様に可能である。

勿論、この場合、薄膜、充填粉末材料としては Co薄膜、Co 基礎合金粉末が用いられる。

### (発明の効果)

本発明は以上のように真空中で高エネルギバイ オンを照射し、接合面変面の清浄化を行なった後、 同接合面にNI薄膜を恋者。形成しその後、接合面 間に粉末を介在させてHIP 処理することによりNi 基場合金の2面の接合を図るものであり、以下の 如き各効果が期待される。

- (イ) 真空中で高エネルギイオンを表面に衝突させることにより、従来の技術では達成不可能であった清浄な表面が得られ、しかも直ちに川薄膜で関われるため、その後、空気に触れても清浄度は何ら変わることがない。このため拡散接合後も境界面に飲化被膜が残ることがなく、接合強度が大巾に向上する。
- (n) 接合面に形成されるNI薄膜は境界面に金属 逆化物が生成するのを防ぐ効果を有し、前記(イ) の効果と相俟ってより信頼性の高い接合部を得る ことができる。
- (n) 上記NI薄膜は母材のベースメクルと同材質であり、しかも20μ以下と薄いので拡散接合後は全く痕跡が残ることはなく、強度の低下を招くことがない。
- (=) 接合面間には隙間を設けて扮来を介在させるので表面にうねり等があっても空隙が残ること

はなく、従って曲面の接合が可能である。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回ないし第3回は本発明方法による接合方法を実施した各例であり、第1回は非透超合金の固体と固体を粉末を介して接合する場合の概要断面図、第2回は形状が複雑な場合の概要断面図、第3回は非透超合金の固体と粉末との接合を示す概要断面図である。又、第4回は本発明方法におけるNiイオン照射及び薄膜形成に利用するイオンプレーティング装置の概要図である。

- (A)(B)…NI基超合金、
- (1),(1), "NI基因合金固体、
- (2)…NI 芬昭合金粉末、
- (3),(3)' ···Ni薄膜、
- 4)…カプセル。







